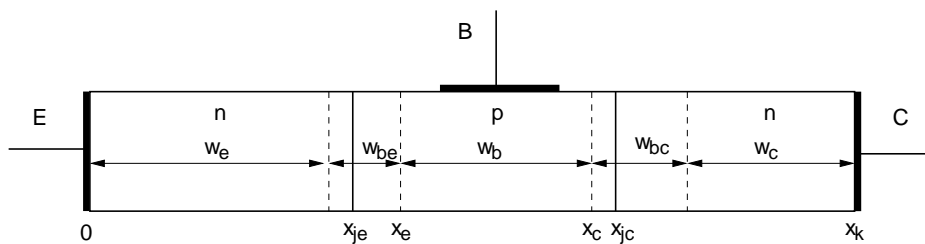


Übung 12 Elektronik I WS 08/09

Gegeben ist ein npn-Si-Bipolar-Transistor bei 300 K mit den folgenden Werten:

- Effektiver homogen vom Strom durchflossener Querschnitt:
 $A = 20 \mu\text{m}^2$
- $L_n = L_p = 50 \mu\text{m}$



- Rechteckprofil-Dotierung mit

$$\begin{aligned} N_E &= 10^{20} \text{ cm}^{-3} & 0 \leq x < x_{je} \\ N_B &= 10^{17} \text{ cm}^{-3} & x_{je} \leq x \leq x_{jc} \\ N_C &= 10^{15} \text{ cm}^{-3} & x_{jc} < x < x_k \end{aligned}$$

mit

$$\begin{aligned} x_{je} &= 2 \mu\text{m} \\ x_{jc} &= 4 \mu\text{m} \\ x_k &= 8 \mu\text{m} \end{aligned}$$

Fehlende Werte können aus der Literatur oder aus dem Skript entnommen werden. z.B. μ_n, μ_p aus Tab. 2.5.

1. Wie groß sind die Bahngebiete w_e , w_b , w_c , sowie die RLZ-Weiten w_{be} , w_{bc} des Transistors im thermodynamischen Gleichgewicht?
2. Der Transistor befindet sich im Arbeitspunkt $U_{BE} = 800$ mV und $U_{BC} = -1$ V. In welchem Betriebsbereich befindet sich der Transistor?

Als freiwillige Zusatzaufgabe berechnen und zeichnen Sie (z.B. mit Matlab, Octave) die Ladungsträgerdichten in den Bahngebieten und RLZ'en im thermodynamischen Gleichgewicht sowie für den Arbeitspunkt.

3. Welche Form besitzen die Minoritätsträgerverläufe in den Bahngebieten bei logarithmischer Darstellung ($\log n_p(x)$, $\log p_n(x)$) und bei linearer Darstellung?

Ist in allen Bahngebieten die Berechnung mit Hilfe der Näherungen für die kurze Diode möglich?

4. Berechnen Sie die Sättigungsströme I_{es} , I_{bs} , I_{cs} des Transistors sowie seine Stromverstärkungen B_F und B_R .
5. Welchen Wert besitzen die Ströme I_{CE} , I_{EC} des Transferstrom-Modells im Arbeitspunkt unter 2.? Wie groß sind I_B , I_E und I_C an den Klemmen des Transistors? Wie groß ist demnach die Stromverstärkung $B = \frac{I_C}{I_B}$?
6. Bestimmen und zeichnen Sie die Kennlinien $I_C(U_{CE})$, $I_C(I_B)$, $I_B(U_{BE})$ mit $U_{BE} = 0 \dots 850$ mV.

Wählen Sie in der Darstellung für U_{BE} eine geeignete Schrittweite. Nehmen Sie zur Vereinfachung der Berechnung $\alpha_T = 1$ an und vernachlässigen Sie die Nettorekombination in den Raumladungszonen. Für die Early-Spannung soll näherungsweise $U_A \rightarrow \infty$ gelten. Machen Sie geeignete Annahmen, falls Ihnen Angaben fehlen.